



(11)Publication number:

08-078950

(43) Date of publication of application: 22.03.1996

(51)Int.CI.

H03B 5/18

(21)Application number: 06-207474

(71)Applicant: TERA TEC:KK

(22)Date of filing:

31.08.1994

(72)Inventor: TAKENAKA TSUTOMU

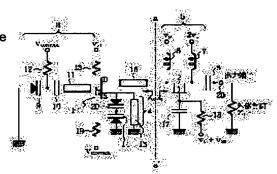
MIYAZAKI ATSUSHI

(54) OSCILLATOR

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the oscillator which can vary an oscillation frequency over wide bands and is suitable for integration.

CONSTITUTION: The oscillator is composed of a first transistor, resonance circuit 3, serial feedback circuit 5 and active load impedance matching circuit 5. This active load impedance matching circuit 5 is composed of a second transistor having a grounded control electrode, input electrode used as an input terminal and output electrode used as an output terminal, and the bands of the variable oscillation frequency can be widened. Besides, a circuit area can be miniaturized and in the case of integration, manufacture cost can be reduced.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.12.1999

[Date of sending the examiner's decision of

25.12.2001

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

BEST AVAILABLE COPY

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-78950

(43)公開日 平成8年(1996)3月22日

(51) Int. Cl.

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H03B 5/18

C 8321-5J

審査請求 未請求 請求項の数6 〇L (全7頁)

(21)出願番号

特願平6-207474

(22)出願日

平成6年(1994)8月31日

(71)出願人 392017118

株式会社テラテック

東京都武蔵野市中町2丁目11番13号

(72)発明者 竹中 勉

東京都武蔵野市中町二丁目11番13号

株式会社テラテック内

(72)発明者 宮崎 淳

東京都武蔵野市中町二丁目11番13号

株式会社テラテック内

(74)代理人 弁理士 井出 直孝

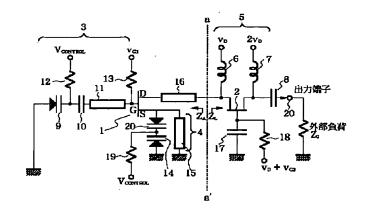
(54) 【発明の名称】発振器

(57)【要約】

【目的】 発振周波数が広帯域に可変でき、かつ集積化 に適した発振器を実現する。

【構成】 発振器は第1のトランジスタ、共振回路、直列帰還回路、能動負荷インピーダンス整合回路とから構成される。ここで、前記能動負荷インピーダンス整合回路は、制御電極を接地、入力電極を入力端子に、出力電極を出力端子とした第2のトランジスタより構成される。

【効果】 可変発振周波数の広帯域化がはかれる。また、回路面積の小型化がはかれ、集積化した場合には製造コストを低減できる。



(2)

10

20

30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1のトランジスタ(1)と、この第1のトランジスタの制御電極(GまたはB)に接続された共振回路(3)と、この第1のトランジスタの入力電極(SまたはE)に接続された直列帰還回路(4)と、この第1のトランジスタの出力電極(DまたはC)に接続される負荷インピーダンス整合回路(5)とを備えた直列帰還型の発振器において、

前記負荷インピーダンス整合回路(5)は、その制御電極を交流的に接地し入力電極を入力端子とし出力電極を 出力端子とする第2のトランジスタ(2)を含む能動型であることを特徴とする発振器。

【請求項2】 前記負荷インピーダンス整合回路(5)の入力インピーダンス(Z₁)が20Ω以下に設定された請求項1記載の発振器。

【請求項3】 前記共振回路(3)は分布定数線路と可変容量ダイオードとの直列回路を含む請求項2記載の発振器。

【請求項4】 前記直列帰還回路(4)は分布定数線路と可変容量ダイオードとの並列回路を含む請求項2記載の発振器。

【請求項5】 前記第1のトランジスタおよび前記第2のトランジスタがいずれも電界効果トランジスタであり、この二つのトランジスタおよびその周辺回路の少なくとも一部が一つの集積回路に実装された請求項2記載の発振器。

【請求項6】 前記第1のトランジスタおよび前記第2のトランジスタがいずれもバイポーラトランジスタであり、この二つのトランジスタおよびその周辺回路の少なくとも一部が一つの集積回路に実装された請求項2記載の発振器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は広帯域に発振周波数を可変できる高周波発振器に利用する。本発明は発振器の集積化、小型化に利用する。

[0002]

【従来の技術】発振器の発振周波数広帯域化への要求があり、その要求に応えるための従来例を図6を参照して説明する。図6は、トランジスタ(2)として電界効果型トランジスタを用い、負荷インピーダンス整合回路(5)に1/4波長の分布定数線路型インピーダンス変成器40を、直列帰還回路(4)にキャパシタ14と分を発展したのかの関係である。

成器40を、直列帰還回路(4)にキャパシタ14と分布定数線路15の並列回路を、共振回路(3)に分布定数線路11と可変容量ダイオード9との直列共振回路を用いたマイクロ波帯での直列帰還型の発振器である。

【0003】図6の回路において発振は、a-a´面より第1のトランジスタの出力電極側を見たインピーダンスを Z、、a-a´面より負荷インピーダンス整合回路側を見たインピーダンスを Z、とした場合、インピーダ 50

ンス Z 、と Z 、との和がゼロとなったとき安定する。インピーダンス Z 、は共振回路 (3) および直列帰還回路 (4) を構成する素子パラメータを適切に設定することで負性抵抗を示すが、トランジスタの寄生容量のため、周波数が高くなるにつれ、設定できる負性抵抗の絶対値は小さくなる。これを補うため、 Z 、を低インピーダンスで成器 40を用いる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来例に示した構成では1/4波長分布定数線路型インピーダンス変成器が大きな面積を必要とし、集積化に大きな弊害となる。また特性に波長依存性のあるため、使用する周波数も限定される。広帯域にわたり低インピーダンスな Z、を実現するため数段の1/4波長分布定数線路によるインピーダンス変成器を用いた例(参考文献、1990年電子情報通信学会春季全国大会誌、C-69、

"9-18GHz帯トリプルバラクタVCO", 君島正幸, 伊藤康之, 益子 行夫) が報告されているが、当該変成器が回路小型集積化を困難にする。また、プリング特性を劣化させバッファアンプまでも必要とすることがある。

【0005】本発明は、このような背景に行われたものであって、発振周波数が広帯域にわたり、かつプリング特性に優れ、集積化に適すよう小型である発振器を提供することを目的とする。

[0006]

あるところにある。

【課題を解決するための手段】本発明は、第1のトランジスタ(1)と、この第1のトランジスタの制御電極(GまたはB)に接続された共振回路(3)と、この第1のトランジスタの入力電極(SまたはE)に接続された直列帰還回路(4)と、この第1のトランジスタの出力電極(DまたはC)に接続される負荷インピーダンス整合回路(5)とを備えた直列帰還型の発振器である。【0007】ここで、本発明の特徴とするところは、前記負荷インピーダンス整合回路(5)は、その制御電極を交流的に接地し入力電極を入力端子とし出力電極を出力端子とする第2のトランジスタ(2)を含む能動型で

40 【0008】前記負荷インピーダンス整合回路(5)の 入力インピーダンス(Z_L)が20Ω以下に設定される ことが望ましい。

【0009】前記共振回路(3)は分布定数線路と可変容量ダイオードとの直列回路を含むことが望ましい。

【0010】前記直列帰還回路(4)は分布定数線路と可変容量ダイオードとの並列回路を含むことが望ました。

【0011】前記第1のトランジスタおよび前記第2のトランジスタがいずれも電界効果トランジスタであり、 この二つのトランジスタおよびその周辺回路の少なくと

1

も一部が一つの集積回路に実装されることが望ましい。 【0012】前記第1のトランジスタおよび前記第2の トランジスタがいずれもバイポーラトランジスタであ り、この二つのトランジスタおよびその周辺回路の少な くとも一部が一つの集積回路に実装されることが望まし

[0013]

Re
$$(Z_{i}) < 0$$
 $\hbar \supset |Re(Z_{i})| \ge Re(Z_{i})$... (1)
Im $(Z_{i}) + Im(Z_{i}) = 0$... (2)

である。ただし、Re (Z,)、Re (Z,)はインピ 10 【0014】発振開始後、トランジスタの利得特性が歪 ーダンスZ、、Z、の実数分であり、Im(Z、)、I m(Z₁)はインピーダンス Z₁、 Z₁の虚数分であ

$$Z_{\Lambda} + Z_{L} = 0$$

を満足するまで発振信号は成長し、上記条件で安定す

Re
$$(Z_{\star}) = -c \circ n s t a n t$$
, Im $(Z_{\star}) = 0$

Re
$$(Z_i)$$
 = constant, Im (Z_i) = 0

の条件が周波数に依らず成り立っていることが望まし い。ただし、R. (Z,) はインピーダンス Z, の実数 20 【0016】ここで一般に 分であり、Im(Z))はインピーダンスZ,の虚数分

$$|Re(Z_i)| \ge |Re(Z_i)|$$

である。

【0017】発振させる周波数が高くなるにつれ、トラ ンジスタの利得特性はその寄生容量素子のため低下し、 負性抵抗の大きさ、 | Re (Z,) | 、 | Re (Z,)

Re (Z_{ι}) =低い値、例えば 20Ω 程度、 $Im(Z_{\iota})=0$ … (7)

であることが必要となる。

【0019】一方、図2は制御電極(ペースまたはゲー ト)を接地、接地電極(エミッタまたはソース)を端子 30

1、出力電極(コレクタまたはドレイン)を端子2とし

【作用】直列帰還型の発振器において、発振を引き起こ す利得素子であるトランジスタと負荷インピーダンス整 合回路の接続点より上記トランジスタの出力電極側を見 た小信号インピーダンスを2.、負荷インピーダンス整 合回路の入力端子側を見たインピーダンスを2.とする とき、発振開始条件は、

$$Z_{i}$$
) $| \geq Re(Z_{i}) \cdots (1)$

みだし、上記接続点よりトランジスタの出力電極側を見 た大信号インピーダンス Z、が

【0015】広帯域発振特性を考慮するならば、(3) 式に加え、さらに

である。

上は共に小さな値となる。

... (6)

作を得るためには、発振周波数に依らず、

ーダンス行列は次式で表される。

たトランジスタの等価回路である。図2の回路のインピ

【0018】したがって、高周波領域で広帯域で発振動

[0020]

$$[Z] = \begin{bmatrix} \frac{1}{j\omega C_1 + \frac{1}{R_1} + g_m} & 0 \\ \frac{g_m}{j\omega C_2 (j\omega C_1 + \frac{1}{R_1} + g_m)} & \frac{1}{j\omega C_2} \end{bmatrix} \cdots (8)$$

ここでg。は相互コンダクタンスを示す。一般に1/R 、 <<g。であり、ωC、<<g。の周波数領域では、

Re
$$(Z_{11}) = 1 / g_{\bullet}$$
, Im $(Z_{11}) = 0$

で近似的に表される。

【0021】図4を参照して図2の回路の入力インピー ダンスの周波数特性の広帯域性能を確認する。図4は図 2の回路の入力インピーダンス周波数レスポンスのシミ ュレーション特性である。 横軸に周波数をとり、縦軸に インピーダンスをとる。図4には比較のため、従来の1 / 4 波長分布定数線路型インピーダンス変成器のシミュ

を満足していることが図4よりわかる。

【0022】したがって、制御電極(ベースまたはゲー 50 端子としたトランジスタを直列帰還型発振器の負荷イン

図2の回路において端子1よりトランジスタを見たイン ピーダンスZiは、

$$=0$$
 ... (9)

レーション特性も合わせて記す。実線が本発明で用いた 能動負荷インピーダンス整合回路特性であり、破線が従 来例の特性である。図4において入力インピーダンス2 L は15Ω、外部負荷インピーダンス L は200Ωと し、設計中心周波数は25GH2とした。広い周波数帯 域にわたり、本発明で用いた能動負荷インピーダンス整 合回路が発振条件、

$$(7) = 0 \qquad \qquad \cdots \quad (7)$$

ト)を接地、入力電極(エミッタまたはソース)を入力

ピーダンス整合回路として用いることにより、発振器の 負性抵抗分が小さくなる高周波領域においても発振が可 能となる。また、発振の可変周波数帯域を広帯域にでき

【0023】また、1/4波長分布定数線路型インピー ダンス変成器を用いずにトランジスター個で負荷インピ ーダンス整合回路を構成しているため、回路面積を小さ くでき、モノリシック集積回路で発振回路を実現する場 合には機器の小型化のみならず製造コスト低減にも寄与 する。

【0024】さらに、トランジスタの単一方向性特性 (アイソレーション特性)により、外部負荷インピーダ ンス 2。 の変動が、発振条件を決める(3)(4)

(5) 式に与える影響を小さくでき、外部負荷変動に対 し安定した発振動作を実現する。

[0025]

【実施例】本発明実施例の構成を図1を参照して説明す る。図1は本発明実施例回路の回路図である。

【0026】本発明は、電界効果型トランジスタ1と、 電界効果型トランジスタ1のゲート電極に接続される共 20 振回路3と、電界効果型トランジスタ1のソース電極に 接続される直列帰還回路4と、電界効果型トランジスタ 1のドレイン電極に接続される能動負荷インピーダンス 整合回路5とを備えた直列帰還型の発振器である。

【0027】ここで、本発明の特徴とするところは、能 動負荷インピーダンス整合回路5が、ゲート電極を交流 的に接地し、ソース電極を入力端子とし、ドレイン電極 を出力端子とした電界効果型トランジスタ2より構成さ

れるところにある。

【0028】本発明実施例においては、能動負荷インピ ーダンス整合回路5の入力インピーダンス2」はおよそ 15Ωに設定されている。

【0029】共振回路3は分布定数線路11と可変容量

ダイオード9との直列共振回路である。また、直列帰還 回路4は分布定数線路15と可変容量ダイオード20、 14との並列接続にて構成される。インダクタ6、7は ドレインバイアス供給用のチョークインダクタである。 10 高抵抗13、18はそれぞれ電界効果型トランジスタ 1、2のゲートバイアス供給用である。可変容量ダイオ ード9、14、20の制御電圧V (0×100) は高抵抗1

【0030】電界効果トランジスタ1、2の代わりにバ イポーラトランジスタ1、2を用いてもよい。

2、19を介して供給される。

【0031】次に、本発明実施例の動作を図1を参照し て説明する。電界効果型トランジスタ1の利得、寄生帰 還容量、共振回路3および直列帰還回路4により、aa ´ 面より電界効果型トランジスタ1のドレイン電極側 を見込んだインピーダンス Z, は特定の周波数で負性抵 抗性を示す。この負性抵抗性は電界効果型トランジスタ 1の寄生容量のため電界効果型トランジスタ1の利得が 低下するのと同等に低下する。

【0032】また、a-a′面より電界効果型トランジ スタ2のソース電極側を見たインピーダンス 2, は、電 界効果型トランジスタ2の相互コンダクタンスg』を用

Re
$$(Z_1) = 1/g_1$$
, Im $(Z_1) = 0$... (9)

で近似的に与えられるため、分布定数線路16を

Re
$$(Z_{\Lambda}) = -constant$$
, Im $(Z_{\Lambda}) = 0$... (4)

の虚数項条件を満たすように設定すれば、発振条件

はすべて満足され、回路は発振し、電界効果型トランジ スタ2のドレイン電極に発振出力を取り出すことができ る。また、電界効果型トランジスタ2のg。をおよそ7 0 m S に設定することで、高周波領域での発振を可能に

Re
$$(Z_{\star}) = -constant$$
, Im $(Z_{\star}) = 0$

が成り立つ周波数を可変でき、(5)式は広帯域にわた り成り立っているので、広範囲に発振周波数を可変でき る.

【0034】図3を参照して本発明実施例回路の動作特 性を説明する。図3は本発明実施例回路の動作特性であ り実際の回路の測定結果を示す図である。図3(a) は、可変容量ダイオード9、14、20のバイアス電圧 を横軸にとり、発振周波数を縦軸にとる。バイアス電圧 が-2.2 Vから+0.8 Vまで変化すると発振周波数 が24.2GHzから27.2GHzまで変化する。

【0033】また、制御電圧Vcoxtuolにより可変容量 ダイオード9、14、20の容量を変化させることによ n.

$$I m (Z_A) = 0 \qquad \cdots (4)$$

【0035】図3(b)は、発振周波数を横軸にとり、 発振出力電力を縦軸にとる。発振周波数が24.2GH zから27.2GHzまで変化しても、全帯域で発振出 力電力はおよそ10dBmで一定値である。これは、本 発振の可変周波数範囲が、可変容量ダイオード9、1 4、20の可変容量比で制限されていることを示してい る。今回用いたものは可変容量比が3程度であるので、 これを可変容量比10程度のものに置き換えることでさ らに発振の可変周波数範囲を20-30GHz程度に広 50 くできる。

【0036】また、外部負荷インピーダンスを半分に変 化させた場合のシミュレーションでは、本実施例の発振 器の振幅変化は5%以下であるのに対し従来例は発振が 停止してしまった。したがってプリング特性においても 本実施例の発振回路は従来例より安定していることがわ かる。

【0037】次に、図5を参照して本発明実施回路を集 積化した状態を説明する。図5は本発明実施例回路を集 積化した状態を示す図である。図5に示すように、集積 化時の回路面積は、例えば発振周波数を25GHzとし た場合、本発明実施例回路では1.5 mm²程度の大き さで実現することができた。従来例では1/4波長分布 定数線路型インピーダンス変成器を用いるためその倍程 度の大きさとなる。言い換えれば、本発明実施例回路を 用いれば製造コストを従来の半分に低減し得ることを示 している。

[0038]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 広帯域にわたり安定した発振動作を行い、集積化に適し た発振器が実現できる。これにより、小型で安価な発振 20 G ゲート電極 器が実現できる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明実施例回路の回路図。
- 【図2】制御電極を接地したトランジスタの等価回路。
- 【図3】本発明実施例回路の動作特性を示す図。

【図4】制御電極を接地した電界効果型トランジスタの 入力インピーダンス Z 、の周波数特性をシミュレーショ ンした結果を示す図。

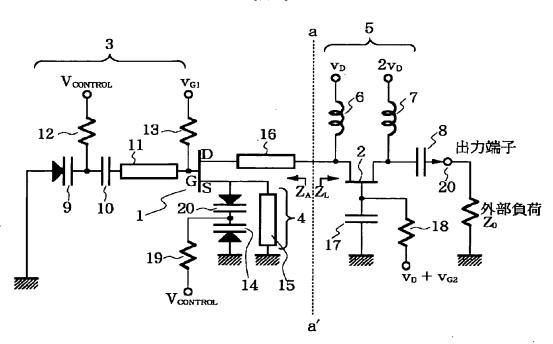
【図5】本発明実施例回路を集積化した状態を示す図。

【図6】負荷インピーダンス整合回路に1/4波長分布 定数線路型インピーダンス変成器を用いた直列帰還型の 発振器の回路図。

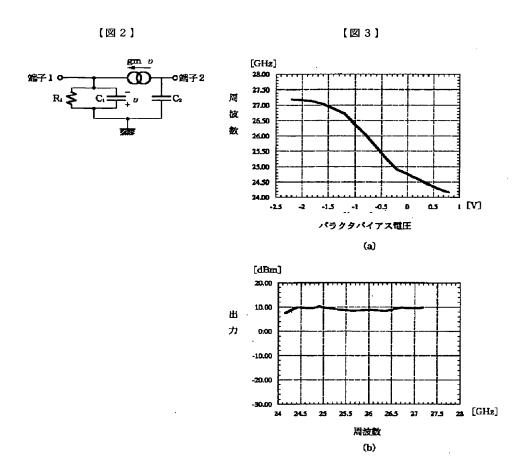
【符号の説明】

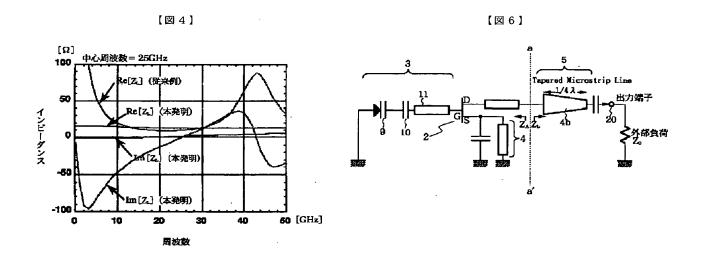
- 1、2 電界効果トランジスタ
- 3 共振回路
- 直列帰還回路
 - 5、負荷インピーダンス整合回路
 - チョークインダクタ
 - 8、10、17 バイアスカット用キャパシタ
 - 9、14、20 可変容量ダイオード
 - 11、15、16 分布定数線路
 - 12、13、18、19 パイアス印加用高抵抗
 - 20 出力端子
 - 40 1/4波長分布定数線路型インピーダンス変成器
- ドレイン電極
- ソース電極
- インピーダンス Z_{λ} , Z_{λ}
- 外部負荷インピーダンス

【図1】



BEST AVAILABLE COPY





BEST AVAILABLE COPY

【図5】

